ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАЛОШУМЯЩИХ ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРИЕМНИКАХ СВЧ

3. Н. Музыка, А. И. Чумаков Харьков

Максимальная дальность радиосвязи, являющаяся одним из основных качественных показателей радиолинии, определяется наряду с некоторыми другими факторами чувствительностью

радиоприемного устройства. Повышение чувствительности современных радиоприемных устройств ограничивается определенным уровнем помех и шумов в радиоприемной аппаратуре.

Если от различного рода помех можно избавиться определенными методами, то в самых благоприятных условиях от помехи «белый

шум» избавиться не удается.

Обстоятельства диктуют необходимость в поиске путей совершенствования радиоприемных устройств и в первую очередь повышения требуемого значения отношения сигнал/шум на выходе радиоприемного устройства. Особенно это необходимо в диапазоне СВЧ, где чувствительность радиоприемника ограничивается почти исключительно внутренними шумами.

Бурное развитие радиоэлектроники в последнее десятилетие привело к разработке целого ряда полупроводниковых приборов. Широкое распространение получили транзисторы, которые в большинстве радиосхем благодаря своим малым габаритам и весу, экономичности и устойчивости к механическим воздействиям заменили обычные электронные лампы. В настоящее время имеются достаточно хорошо разработанная теория и методы инженерных расчетов радиоаппаратуры на полупроводниках [1, 2, 3].

Однако биполярные транзисторы по ряду параметров значительно уступают электронным лампам. В связи с этим наряду с совершенствованием технологии изготовления обычных (биполярных) транзисторов, улучшением их усилительных свойств, расширением диапазона рабочих частот и мощностей ведется разработка новых полупроводниковых приборов.

Один из таких приборов — полевой транзистор. Использование его вместо ламп, которые он напоминает, и биполярных транзисторов позволяет не только упростить электронные схемы, повысить надежность, уменьшить вес и габариты, но и создать схемы, реализация которых на других активных приборах затруднена.

В отличие от биполярных транзисторов работа полевых приборов основана на движении основных носителей в полупроводнике, управление током в выходной цепи осуществляется управляющим напряжением, поэтому их усилительные свойства характеризуются крутизной. Они обладают высоким входным сопротивлением, малым уровнем шумов, достаточно высокой термостабильностью и радиационной стойкостью.

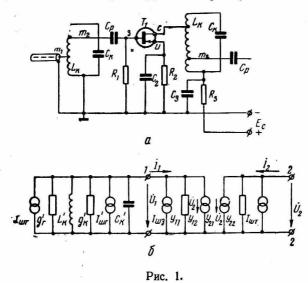
Внутренние шумы в радиоприемном устройстве создаются всеми каскадами, однако при расчете коэффициента шума приемника достаточно учитывать шумы первых одного-двух каскадов, так как шумы последующих каскадов добавляются уже к усиленным шумам и существенно изменить их не могут. Это видно из соотношения для коэффициента шума радиоприемного устройства:

$$\mathbf{\Pi} = \frac{\mathbf{\Pi}_{\mathbf{y}_{\mathbf{B}\mathbf{q}}}}{\mathbf{K}_{\rho\mathbf{n}\mathbf{q}}^{0}} + \frac{\mathbf{\Pi}_{\mathbf{c}_{\mathbf{M}}} - 1}{\mathbf{K}_{\rho\mathbf{n}\mathbf{q}}^{0}\mathbf{K}_{\rho\mathbf{y}_{\mathbf{B}\mathbf{q}}}^{0}} + \frac{\mathbf{\Pi}_{\mathbf{y}_{\mathbf{n}\mathbf{q}}} - 1}{\mathbf{K}_{\rho\mathbf{n}\mathbf{q}}^{0}\mathbf{K}_{\rho\mathbf{y}_{\mathbf{B}\mathbf{q}}}^{0}\mathbf{K}_{\rho\mathbf{c}_{\mathbf{M}}}^{0}}, \dots,$$
(1)

где K_{pi}^{o} — коэффициент передачи по номинальной мощности i-го каскада радиоприемника.

За последние годы разработаны и успешно внедряются в радиотехническую СВЧ аппаратуру высокочастотные биполярные транзисторы, туннельные, параметрические и переключающие диоды.

Расчеты и экспериментальные исследования показывают, что входные устройства приемников на полупроводниках обеспечивают чувствительность, которая выше чувствительности приемных устройств на электровакуумных приборах.



Выпускаемые нашей промышленностью полевые транзисторы (2П-301A, A534Б, ТН12М) благодаря низкому уровню шумов и визкому уровню перекрестной модуляции целесообразно применять во входных каскадах усилителей высокой частоты приемников и частот (500—600) Мац.

Как показывают расчет и анализ схем УВЧ на полевых транэисторах, наименьшим коэффициентом шума Ш обладает транзисторный УВЧ, собранный по схеме с общим истоком. Общее выражение коэффициента шума транзисторного УВЧ с общим истоком рис. 1) имеет вид

$$III = 1 + \frac{g_{\kappa}' + g_{c}}{g_{r}'} + \frac{g_{21H}}{g_{r}'} \frac{\left| (g_{r}' + g_{\kappa}' + g_{11})^{2} + (b_{r}' + b_{\kappa}' + b_{11})^{2} \right|}{\left| y_{21} \right|^{2}}, \quad (2)$$

тие g_{κ} — пересчитанная к полюсам 1-1 активная проводимость контура;

 g_r — активная проводимость генератора сигнала; g_{21n} — проводимость прямой передачи на участке насыщения;

 $g_{\rm c}$ — проводимость емкостей связи, равная величине $\frac{0.12\omega^2C_{11}^2}{g_{21i}}$ [5]

$$g'_{\mathbf{r}} = \frac{m_1^2}{m_2^2} g_{\mathbf{r}}; g'_{\mathbf{k}} = \frac{1}{m_2^2} g_{\mathbf{k}}; m_1 = \frac{U_{\mathbf{r}}}{U_{\mathbf{k}}}; m_2 = \frac{U_1}{U_2}.$$
 (3)

В выражении (2) предполагается, что шумовая температура генератора сигнала, контура и транзистора равны комнатной тем-

пературе.

Путем настройки входного контура усилителя в резонанс с частотой усиливаемого сигнала можно добиться компенсации реактивных проводимостей в (2) и, следовательно, добиться уменьшения коэффициента шума:

$$b_{\rm r}' + b_{\rm K}' + b_{11} = 0. (4)$$

Выражение (2) можно также представить следующим образом:

$$\coprod_{0} = 1 + \frac{g_{\kappa}^{1} + g_{c}}{g_{\Gamma}^{1}} + \frac{R_{m}}{g_{\Gamma}^{\prime}} (g_{\Gamma}^{\prime} + g_{\kappa}^{\prime} + g_{11})^{2}, \tag{5}$$

где $R_{\mathbf{m}} = \frac{g_{21H}}{|y_{21}|^2}$ — шумовое сопротивление транзистора.

Из соотношения (5) видно, что коэффициент шума УВЧ зависит от частоты (g_c , g_{11} , $|\mathcal{Y}_{21}| = \varphi(f)$) исходного рабочего режима, типа транзистора и режима согласования на входе усилителя (m_1 и m_2).

В резонансных усилителях наиболее часто используются три режима работы: режим согласования, режим оптимального согла-

сования и режим оптимального рассогласования [4].

В режиме согласования $(g_r = g_\kappa + g_{11})$ обеспечивается наибольшее напряжение на входе транзистора и режим бегущей волны в фидере. Обеспечивается режим согласования выбором коэффициентов трансформации: $m_1 < 1$ и $m_2 \leqslant 1$.

Полагая в (5) коэффициент трансформации $m_2 = 1$, получаем выражение для коэффициента шума резонансного усилителя с об-

щим истоком в режиме согласования:

$$\coprod_{c} = 1 + \frac{g_{\kappa} + g_{c}}{g_{\kappa} + g_{11}} + 4R_{\mathfrak{m}} (g_{\kappa} + g_{11}). \tag{6}$$

На частотах до f=100~Mги проводимость $g_{\rm K}\gg g_{11}$, при этом выражение (6) в режиме согласования примет сравнительно простой вид:

$$\coprod_{c} = 2 + \frac{g_{c}}{g_{\kappa}} + 4R_{m}g_{\kappa}. \tag{7}$$

Из выражения (6) видно, что коэффициент шума имеет довольно сложную зависимость от проводимости контура g_{κ} . Очевидно, в общем случае есть возможность путем выбора оптимального зна-

чения проводимости контура получить минимальное значение коэффициента шума, сохранив при этом режим согласования на входе усилителя. Такой режим работы называется режимом оптимального согласования.

Оптимальное значение проводимости $g_{\kappa \text{ опт}}$ определяется из условия равенства нулю частной производной $\frac{d \Pi_c}{d g_u'}$ выражения (5):

$$g_{K \text{ ont}} = \sqrt{\frac{g_{c} - g_{11}}{4R_{III}}} - g_{11}. \tag{8}$$

Минимальное значение коэффициента шума усилителя при этом

$$\coprod_{\text{oc MHH}} = 2 + 4 \sqrt{R_{\text{III}} (g_{\text{c}} - g_{11})}$$
 (9)

Коэффициенты трансформации m_1 и m_2 в режиме оптимального согласования находим из соотношений:

$$m_{1c \text{ ont}}^2 = \frac{g_{\kappa} + m_{2c \text{ ont}}^2 g_{11}}{g_{11}}; \tag{10}$$

$$m_{2c \text{ out}}^2 = \frac{g_{\kappa}}{\sqrt{\frac{g_c - g_{11}}{4R_{\text{III}}} - g_{11}}}; \qquad (11)$$

$$g_{\text{K Offf}} = m_2^2 \left(\sqrt{\frac{g_{\text{c}} - g_{11}}{4R_{\text{in}}}} - g_{11} \right).$$
 (12)

Коэффициент шума каскада может быть сведен к минимуму применением режима оптимального рассогласования посредством подбора связи входной цепи прибора с источником сигнала, т. е. изменением величины g_r .

Взяв производную $\frac{d \Pi_c}{d g_r'}$ от выражения (5) и приравняв ее нулю, получим величину g_r опт, обеспечивающую минимум коэффициента шума:

$$g_{r \text{ onr}}^{\prime} = (g_{\kappa}^{1} + g_{11}) \sqrt{1 + \frac{g_{\kappa}^{\prime} + g_{c}}{R_{m} (g_{\kappa}^{\prime} + g_{11})^{2}}}$$
 (13)

Выражение для минимального коэффициента шума каскада в режиме оптимального рассогласования примет вид

$$\coprod_{MH} = 1 + 2R_{\text{III}} \left(g_{\text{K}}' + g_{11} \right) \left[1 + \sqrt{1 + \frac{g_{\text{K}}' + g_{\text{C}}}{R_{\text{III}} \left(g_{\text{K}}' + g_{11} \right)^2}} \right]. \tag{14}$$

Анализ выражений (6) и (14) показывает, что коэффициент шума резонансного усилителя СВЧ в режиме согласования и в режиме оптимального рассогласования уменьшаются с уменьшением проводимости входного контура g'_{κ} , которую можно уменьшать

как в режиме согласования путем увеличения коэффициента трансформации m_2 до единицы, так и в режиме оптимального рассогласования, увеличивая одновременно m_1 так, чтобы проволимость источника g_{r} опт удовлетворяла условию

$$g_{\Pi} \geqslant g_{\Gamma \text{ OHT}}$$
 (15)

Приняв коэффициент трансформации $m_2=1$, получим минимальное значение коэффициента шума в режиме оптимального рассогласования:

$$\coprod_{MH} = 1 + 2R_{\text{III}} (g_{\text{K}} + g_{11}) \left[1 + \sqrt{1 + \frac{g_{\text{K}} + g_{\text{C}}}{R_{\text{III}} (g_{\text{K}} + g_{11})^2}} \right]. (16)$$

При этом оптимальное значение проводимости источника сигнала определяется выражением

$$g'_{r \text{ ont}} = (g_{\kappa} + g_{11}) \sqrt{1 + \frac{g_{\kappa} + g_{c}}{R_{ll} (g_{\kappa} + g_{11})^{2}}}$$
 (17)

Из выражения (17) определяется оптимальное значение коэффициента трансформации $m_{1 \text{ onr}}$:

$$m_{1 \text{ onr}}^2 = \frac{g_{\kappa} + g_{11}}{g_{r}} \sqrt{1 + \frac{g_{\kappa} + g_{c}}{R_{\text{III}} g_{\kappa} + g_{11})^2}}.$$
 (18)

В тех случаях, когда значение проводимости источника сигнала g_r меньше оптимального значения проводимости $g_{r \text{ опт}}$. выбирают коэффициент трансформации m_1 равным единице, а оптимальное значение проводимости источника сигнала $g_{r \text{ опт}}$ обеспечивается путем выбора коэффициента трансформации m_2 . В этом случае выражение для коэффициента трансформации m_2 равно

$$m_2^2_{\text{out}} = \sqrt{\frac{R_{\text{II}} (g_{\text{r}} + g_{\text{K}})^2}{g_{\text{c}} + R_{\text{III}} g_{11}^2}},$$
 (19)

а выражение для минимального значения коэффициента шума в режиме оптимального рассогласования при невыполнении условия (15) примет вид

$$\coprod_{MRH} = 1 + \frac{g_{K}}{g_{r}} + 2R_{m}g_{11}\frac{g_{r} + g_{K}}{g_{r}} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{g_{c}}{R_{m}g_{11}^{2}}} \right]. \quad (20)$$

Таким образом, коэффициент шума резонансного усилителя с общим истоком в режиме оптималного рассогласования во всех случаях можно вычислить по формулам (16) и (20).

Расчет коэффициента шума резонансного усилителя в рассмотренных режимах сведен в таблицу, по данным которой построены графики зависимостей (рис. 2) $\coprod_c = \varphi_1(f)$; $\coprod_{\infty \text{ мин}} = \varphi_2(f)$ и $\coprod_{\text{мин}} = \varphi_3(f)$.

f, Мгц	1	10	30	100	150	200	250	300	400
Ш _с , _{раз}	2,2	2,2	2,4	3,94	4,87	5,72	6,67	7,7	9,3
Ш _{ос.мин}	2,01	2,13	2,38	3,29	3,86	4,45	5,11	5,7	7,06
Ш _{мин}	1,56	1,58	1,6	1,94	2,3	2,67	3,00	3,44	4,2

На этом же рисунке для сравнения пострсена зависимость $\coprod_{MH} = \varphi_A(f)$ биполярного транзистора 1Т313A.

Анализ приведенных зависимостей показывает, что во всем

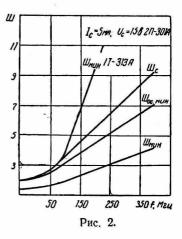
диапазоне частот Шмин значительно меньше Шос мин и Шс.

Поэтому в резонансном усилителе СВЧ целесообразно при-

менять режим оптимального рассогласования с целью получения ми- ш

нимума коэффициента шума.

Коэффициент шума резонансного усилителя СВЧ на полевом транзисторе (2П 30ІА) значительно меньше (на 50 - 100 %) коэффициента шума высокочастотных биполярных транзисторов (П411,1Т313А) до частот (50—100) Meu. Ha частотах 100 Мги и выше коэффициент шума резонансного усилителя, собранного на транзисторе 1Т313А, на (400-800) % выше коэффициента шума усилителя СВЧ, собранного на полетранзисторе 2П301А, поэтому очевидна целесообразность примене-



ния полевых транзисторов во входных каскадах радиоприемных устройств с целью увеличения их чувствительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. С. М. Герасимов, И. Н. Мигулин, В. Н. Яковлев. Основы

теории и расчета транзисторных схем. Изл-во «Советское радио», 1963, 664 с. 2. С. Е. Фалькович, З. Н. Музыка. Чувствительность радиоприемных устройств с транзисторными усилителями. Изд-во «Энергии», 1970. 128 с. 3. Н. А. Смогилев. Радиоприемники СВЧ. Воениздат, 1967. 556 с.

4. А. А. Куликовский, Линейные каскалы радиоприемников. Гос-энергоиздат, 1958, 352 с.

5. Полевые транзисторы. Перевод с английского под редакцией С. А. Майорова. Изл-во «Советское радио», 1971. 374 с.